

「環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギーのための
材料とシステム研究拠点」

2025年度 名古屋大学未来材料・システム研究所
共同利用・共同研究（国際共同研究）公募要項

1. 共同利用・共同研究の趣旨と公募内容

名古屋大学未来材料・システム研究所（以下「本研究所」という。）は、学内唯一の理工学系附属研究所であるエコトピア科学研究所を改組し、2015年10月1日に設置されました。本研究所は、新しい材料・システムの研究に取り組み、環境調和型持続可能社会の実現に寄与することを目的としています。

2016年度より6年間、共同利用・共同研究拠点として、文部科学省から認定された「革新的省エネルギーのための材料とシステム研究拠点」は、革新的省エネルギー（エネルギーの創出・変換、蓄積、伝送、消費の高度化・超効率化）を実現するために、先端的な材料・デバイス等の要素技術に関する基礎研究から社会実装のためのシステム技術までを一貫して俯瞰し、これを学内外・国内外の研究者の共同利用・共同研究によって推進してきました。

また、2022年度より6年間、共同利用・共同研究拠点として新たに文部科学省から認定された「環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギーのための材料とシステム研究拠点」は、環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギー技術（エネルギー変換、蓄エネルギー、エネルギー伝送およびエネルギー消費の高度化・超効率化）の開発を実現するために、先端的な材料・デバイス等の要素技術に関する基礎研究から社会実装のためのシステム技術の開発までを一貫して俯瞰し、これを学内外・国内外の研究者の共同利用・共同研究によって推進します。

この拠点活動の一環として、海外を研究拠点とする研究者と本研究所の教員とが協力して行う、環境調和型で持続発展可能な省エネルギー・創エネルギー技術の開発に関する国際共同研究を公募します。

※共同利用・共同研究

本研究所の教員及び本学以外の国外の研究機関に所属する教員又は研究者を含む研究チーム（研究チームは「2. 研究組織」を参照）が、本研究所の施設、設備、データ等を利用して共同で行う研究

2. 研究組織

本国際共同研究では、研究組織の中に、研究代表者もしくは研究分担者として海外を研究拠点とする研究者が一名以上含まれている必要があります。また、研究所担当教員として本研究所の所員が一名以上含まれている必要があります。研究課題、研究内容、経費等について事前に本研究所の担当教員と十分な打ち合わせをしてください。

研究代表者および研究分担者は、次のいずれかに該当する者としします。

- ① 国、公、私立大学の教員、研究機関の研究者、又はこれらに準ずる研究者
- ② 国外の研究機関に所属する研究者（名誉教授、ポスドクを含む。博士の学位を有すること）。
- ③ その他研究所長が特に適当と認めた者

3. 申請額及び採択件数

- ① 新規申請上限額：100万円(2年間)

経費の使用は、本研究所内で共同利用・共同研究を遂行するために必要とする旅費、消耗品(共同利用・共同研究に直接必要としない文具品等を除く)、本研究所設備の使用料金(学内料金)等、共同利用研究に関連したものに限ります。

採択予定件数：4件程度

- ② 継続申請上限額：50万円(1年間)

2年目終了時に継続を希望する課題については、もう1年間継続申請することができます。継続申請は50万円を上限として経費の申請が可能です。

4. 研究期間

研究期間は、採択日から2027年2月末日までの2年間とします。ただし、継続申請の研究期間は1年間となります。

5. 申請方法

- ① 同一の研究者が研究代表者として申請できる件数は1件(課題)のみです。

(継続申請する場合は、新規申請はできません。)

- ② 共同利用・共同研究を希望する場合、研究代表者は、共同利用・共同研究課題、研究内容、経費等について事前に本研究所の担当教員と十分な打合せをしてください。

- ③ 共同利用・共同研究を実施するに当たっては、本研究所の設備(別紙資料「主な設備一覧」参照)を利用することができます。なお、利用を希望する場合は、本研究所の担当教員と事前に打合せをしてください(設備の管理者にもあらかじめご相談ください。)

- ④ 共同利用・共同研究の新規又は継続の申請に当たっては、別添「名古屋大学未来材料・システム研究所共同利用・共同研究申請書」(別紙様式1)をEメール(MS-Word文書)で「11.提出先」へ提出してください。

- ⑤ 申請書の書式ファイルは本研究所のホームページからダウンロードできます。次のURLをご覧ください。

ダウンロードページ：<https://www.imass.nagoya-u.ac.jp/joint/>

- ⑥ 英語による申請も可能です。

- ⑦ 共同利用・共同研究に参加する大学院生は、学生教育研究災害障害保険への加入をお願いします。

6. 申請期限

2025年1月15日(水) 期限厳守

7. 審査

- ① 共同利用・共同研究の採否は、共同利用・共同研究委員会の審議を経て、研究所長が決定します。

- ② 審査にあたり、共同利用・共同研究委員会は必要に応じて研究代表者に申請課題の内容についてお伺いすることがあります。

- ③ 審査結果については、2025年4月中に、研究代表者あてに連絡します。採択された共同利用・共同研究課題については、ホームページに掲載（共同利用・共同研究課題名、研究代表者名、研究代表者所属機関）しますので、予めご了承ください。

8. 共同利用・共同研究報告書

提出していただいた共同利用・共同研究報告書については、本研究所のHPにまとめて公表します。また、採択された共同利用・共同研究課題については、計画や研究成果を本研究所が主催する「持続性社会のための材料とシステムに関する国際会議 International Conference on Materials and Systems for Sustainability (ICMaSS)」において、発表していただきます。

なお、次回のICMaSSは2025年11月頃開催を予定しております。

また、学術雑誌等への成果発表を推奨します。

- ① 「名古屋大学未来材料・システム研究所共同利用・共同研究報告書」（別紙様式2-1,2-2以下「研究報告書」という。）を締切日（④参照）までに「11. 提出先」へMS-Word文書で提出してください。
- ② 研究報告書の作成にあたっては、別紙様式2-1はA4サイズ1頁に、別紙様式2-2は図表等を含めてA4サイズ3頁になるようにしてください。
- ③ 共同利用・共同研究の成果について論文を発表する場合（口頭発表を含む。）は、当該論文の謝辞（acknowledgements）の欄に本研究所の共同利用・共同研究による旨を付記してください。参考として、次の例文を挙げておきます。

- This work was carried out by the joint usage / research program of the Institute of Materials and Systems for Sustainability (IMaSS), Nagoya University.

- 本研究は、名古屋大学未来材料・システム研究所における共同利用・共同研究として実施された。また、公表された論文の電子版を「11. 提出先」へメールで提出してください。なお、電子版がない場合は、その印刷物又はコピー1部を「11. 提出先」へ送付してください。

- ④ 研究報告書の提出期限は、2027年3月1日（月）とします。なお、研究期間3年目の継続申請であっても当該年度分を必ず提出してください。

また、1年間の継続が認められた場合は、2028年3月1日（水）までに継続期間分の報告書を提出してください。

- ⑤ 研究報告書が提出されない場合は、翌年度の申請は受理しませんので、ご注意ください。
- ⑥ 報告書の書式ファイルは本研究所のホームページからダウンロードできます。次のURLをご覧ください。

報告書：<https://www.imass.nagoya-u.ac.jp/joint/>

9. 共同利用・共同研究によって生じた知的財産権の取扱い

共同利用・共同研究の実施により生じた知的財産権の取扱いは、名古屋大学共同研究規程を準用します。

学術研究・産学官連携推進本部ホームページ：<https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/index.html>

10. 宿泊施設

共同利用・共同研究実施のため宿泊を必要とする方は、本学の宿泊施設を利用することができます。その場合、本研究所の担当教員又は研究協力部研究事業課にお申し込みください。

11. 提出先・問い合わせ先

〒464-8601 愛知県名古屋市千種区不老町
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学
教学事務部門研究協力部研究事業課（研究所事務部内サテライト）
TEL:052-789-4508
E-Mail : k-kyoten@t.mail.nagoya-u.ac.jp

主な設備一覧

【成膜装置】

設備(設備群)名	仕様	設置場所	連絡先	学内料金 (円/時間)
8元マグネトロンスパッタ装置	2インチカソード8本 試料サイズ30 mm角 RF電源 500 W 2台 基板加熱:600°C 1 kV Arイオンエッチング機構 試料交換室に8サンプルバンク可	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,700
8元MBE装置	蒸着源:4cc蒸着源4個、2cc蒸着源2個 試料サイズ30 mm角 高圧電源3台 基板加熱:1000°C 1kV Arイオンエッチング機構 25 kV RHEED表面観察機能	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,900
3元マグネトロンスパッタ装置 島津製作所 HSR-522	4インチカソード3本、RF電源500 W 2台 逆スパッタ機構、基盤回転、シャッター 開閉機構による多層膜成長可能	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,600

【微細加工・プロセス装置】

設備(設備群)名	仕様	設置場所	連絡先	学内料金 (円/時間)
電子線露光装置 日本電子 JBX6300FS	加速電圧:25/50/100kV 最小ビーム径:2nm ビーム電流:100pA-2nA 重ね合わせ精度:±9nm 最大試料サイズ:8inch φ	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	4,100
マスクレス露光装置 ネオアーク社製 PALET DDB-701-DL4	露光領域:100 mm x 100 mm 最大ワークサイズ:Φ150mm x 10 mm 光源:365 nm LED 最小画素:3 μm(対物レンズx10), 15 μm(対物レンズx2)	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,300
ECR-SIMSエッチング装置	ECRイオンガン:入江工研社製RGB-114 マイクロ波入力150 W、加速電圧600 V、イオン照射径30mm SIMS検出器:PFEIFFER社製 EDP400 分析質量1-512 amu 試料角度調整、回転機構付き	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,100
イオン注入装置 日新電機 NH-20SR-WMH	加速電圧:5-200kV 注入電流1 μA~100 μA	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,900
フェムト秒レーザー加工分析システム 輝創 UFL-Hybrid	光源:1041 nm, 550 fs, 10 μJ (IMRA μjewel D-1000) 高調波発生ユニット:40% @520 nm, 5% @347 nm (加工ステーション) 最大試料寸法:100 mm x 100 mm 加工スポット:3.5 μm φ (分析ステーション) 時間分解蛍光・磁気分析 (光干渉断層撮影ステーション) 撮影エリア:10 mm x 10 mm x 1.6 mm 深さ分解能:7 μm	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	3,800

電気炉 光洋リンドバーク MODEL272-2	温度範囲:400-1100°C	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,700
急速加熱処理装置 AG Associates Heatpulse 610	温度範囲:400~1200°C 昇温速度:200°C/sec	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,000
RIEエッチング装置 Samco RIE-10NR	・シリコン系エッチング ・対応基板サイズ:最大8インチ ・プロセスガス:CF4, Ar, O2	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,900
電子線描画用データ処理 ソフトウェア GenISys BEAMER	・レイアウトエディタ ・パターンデータ変換 ・近接効果補正(PEC) ・グレースケール露光補正	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,700

【電子顕微鏡及び関連装置】

設備(設備群)名	仕様	設置場所	連絡先	学内料金 (円/時間)
反応科学超高压 走査透過電子顕微鏡 JEM 1000K RS	TEM点分解能:0.15nm以下 STEM機能プローブ径:1nm 加速電圧:1000kV, 800kV, 600kV, 400kV 0.1気圧までの各種ガス環境下でのそ の場観察(質量分析による反応ガス検 出機能) EELSによる元素分析機能 3D観察	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	3,100
高分解能電子状態計測走 査透過型電子顕微鏡 JEM-ARM200F(Cold) (収差補正電子顕微鏡)	TEM点分解能:0.19nm STEM機能プローブ径:有<60pm 照射レンズ系に収差補正機能を搭載 加速電圧:200,80kV0 冷電界放出電子銃 TEM, STEM, EDS, EELS	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	1,300
電界放出走査透過電子顕 微鏡 EM-10000BU (収差補正電子顕微鏡)	TEM点分解能:0.11nm STEM機能プローブ径:有<70pm 照射レンズ系、結像レンズ系のそれぞ れに収差補正機能を搭載 加速電圧:200,80kV 電界放出電子銃 TEM, STEM, EDS, EELS 電子線ホログラフイー 高感度/高速カメラによる4D-STEM 遠隔画面共有システム	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	1,200
高分解能透過型電子顕微 鏡システム JEM-2100F-HK	TEM点分解能:0.2nm STEM機能 加速電圧:200kV 電界放出電子銃 TEM, STEM, EDS	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	900
透過電子顕微鏡システム JEM-2100plus	TEM点分解能:0.25nm STEM機能有 プローブ径:3.0nm	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	700
電子分光走査透過電子顕 微鏡 JEM2100M	TEM点分解能:0.23nm STEM機能有 プローブ径:1.0nm 加速電圧:200kV EELS, EDS, 波長分散X線分光器 カソードルミネッセンス(CL) 100K-1000Kの温度範囲で計測可	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	1,000
高速加工観察分析装置 MI-4000L (FIB-SEM)	加速電圧:30kV (FIB, SEM) マイクロサンプリング機能 FE-SEM, EDS およびEBSDF機能	超高压電子顕微鏡施設	超高压電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	1,700

集束イオンビーム加工機 FB-2100(FIB)	加速電圧: 40kV マイクロサンプリング CAD機能	超高圧電子顕微鏡施設	超高圧電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	1,800
アルゴンイオン研磨装置 PIPS II	イオン銃: 低エネルギー集束電極ペニングイオン銃 2式 イオンエネルギー: 100eV~8keV 試料サイズ: 3mm 試料回転: 1~6rpmまで可変 XY切り替え範囲: ±0.5mm 試料観察: 双眼顕微鏡、デジタルズーム マイクロSCOPE 冷却ステージ: 液体窒素(保持時間6~7時間) 試料冷却: -120°Cまで冷却可能	超高圧電子顕微鏡施設	超高圧電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	300
その他 試料作製装置群	切断、機械研磨、化学研磨、FIB用サンプル加工等、無機材料系試料作製のための各種装置群	超高圧電子顕微鏡施設	超高圧電子顕微鏡施設 hvem*@*nagoya-microscopy.jp	200
電界放射型分析走査電子顕微鏡 日本電子 JSM-6330F	線源: 冷陰極電界放射型電子銃 加速電圧: 0.5~30kV 倍率: 10~500,000	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@*imass.nagoya-u.ac.jp	1,500
エネルギー分散型X線分析装置付走査型電子顕微鏡 日立ハイテクノロジーズ S3000N	SEMEDX III TypeN1 SEI像分解能: 3.0nm@ 25kV COMPO像分解能: 4.0nm 加速電圧: 0.3~30kV	共同教育研究施設第3実験棟 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@*imass.nagoya-u.ac.jp	1,500
透過電子顕微鏡システム 日本電子 JEM-2010F	加速電圧200kV 点分解能0.19nm STEM機能	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@*imass.nagoya-u.ac.jp	900
高分解能走査型電子顕微鏡 日本電子 JSM-IT800	・加速電圧: 0.01kV~30kV ・ステージバイアス電圧: 0~-5kV ・分解能: 0.5nm(15kV), 0.7nm(1kV) ・倍率: ~2,000,000 ・最大試料サイズ: 170mmφ x 45mm ・EDS分析元素範囲: Be~Cf	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,500

【分析・計測装置】

設備(設備群)名	仕様	設置場所	連絡先	学内料金 (円/時間)
全自動X線回折装置 RIGAKU SmartLab	・線源: Cu Kα線 9kW ・光学系: 集中法, 平行ビーム法, インプレーン ・多層膜ミラー, Geモノクロメーター付き ・検出器: HyPix-3000二次元検出器 ・測定モード: $\theta-2\theta$ スキャン, ロッキングカーブ, 逆格子面マッピング, 膜面内 ϕ スキャン, $\phi-2\theta$ χ スキャンなど	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,700
X線回折装置 試料水平型 RIGAKU RINT2500TTR	Cu Kα線 18kW, 試料水平型 測定モード: $\theta-2\theta$, θ_s/θ d連動スキャン, θ_s , θ d単独スキャンなど	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@*imass.nagoya-u.ac.jp	1,000
原子間力顕微鏡 Bruker AXS Dimension3100	スキャン領域: XY方向 約90 μ m, Z方向 約6 μ m 試料サイズ: 最大150 mmφ -12mmt 測定モード: AFM, MFM, EFM, LFM, 表面電位顕微鏡, 電流像, リソグラフィ	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@*nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,000

磁気特性評価システム群	(1)交番磁界勾配型磁力計:感度 10^{-8} emu, 20kOe (2)振動試料型磁力計:感度 10^{-5} emu, 15kOe (3)トルク磁力計: 2×10^{-3} erg, 15kOe (4)磁気光学スペクトロメータ: 2×10^{-3} deg, 16kOe	IB電子情報館・岩田研	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	(1) 1,300 (2) 1,300 (3) 1,000 (4) 1,200
X線光電子分光装置 VG ESCALAB250	Mg/Alツインアノード AlモノクロX線源 Arスパッタ銃 角度分解測定用マニピレータ 最大試料サイズ:20mmφ	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,400
原子間力顕微鏡 パーク・システムズ NX20	・スキャン領域:XY方向100μm, Z方向15μm ・試料サイズ:最大200mmφ -20mmt ・測定モード AFM, MFM, EFM, LFM, FMM, C-AFM, ナノリソグラフィ	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	1,300
物理特性測定装置 日本カンタム・デザイン DynaCool-12T	・温度範囲:1.85K~400K ・最大印加磁場:12T ・測定オプション:直流抵抗, Van der Pauw-ホール輸送特性, 試料振動型磁力計(VSM), 試料回転機構	先端技術共同研究施設	ARIM微細加工事務局 info*@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp	2,300
X線光電子分光装置 島津製作所 ESCA-3300型	φ100μmの微小部分分析可能 X線銃:Mg/Alツインアノード 出力最大450W(15kV-30mA) エッチングイオン銃	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	2,000
イメージングXPSマイクロプローブ サーモフィッシャー ESCALAB 250Xi	UPS, XPS両光電子分光計測が可能 XPS計測時:Mg, Al ツインアノード利用可 最高エネルギー分解能:0.5eV程度@ Alk α 最高空間分解能:20μm	総合研究実験棟1階 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	2,500
誘導結合プラズマ発光分光分析装置 セイコーインスツルメンツ SPS7800	シーケンシャル型 波長範囲 175~800nm 最大出力 1.2kW オートサンブラーなし	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	3,000
CHNコーダー ヤナコ分析工業 MT-6	自己積分法式(デュアルピストンポンプ使用) 絶対誤差 ±0.3%以内 オートサンブラーあり	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	2,500
ガスクロマトグラフ質量分析計 島津製作所 GCMS-QP2010Ultra	質量測定範囲1.5~1090Da SCAN/SIM同時分析可能(FASST) Eiイオン源(S/N 500: 1pg octafluoronaphthalene) オートサンブラーあり	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	800
高速液体クロマトグラフィー 島津製作所 LC-20AD	マイクロ流量で優れた性能が得られる並列ダブルプランジャ型2台、グラジエント可能 流量範囲:0.0001~10.0000mL/min 検出器:ホトダイオードアレー(PDA) セミマイクロセル オートサンブラーあり	研究所共同館 II 1F 共通機器室	共通機器管理室 shared.equip*@imass.nagoya-u.ac.jp	300

(注)募集研究テーマを実施するに当たっては、本研究所の設備(主な設備名は上記のとおり)を利用することができます。

なお、利用を希望する場合は、本研究所の担当教員と十分な打合せをしてください。

メール送信の際は@前後の*を除いてください。